

STRJ ワークショップ 2012 プログラム
開催日：2013/3/8(金)、会場：コクヨホール

3/8(金) 9:00 – 17:35

8:20 - 8:55 受付

8:55 - 9:00 開会の辞 石内 秀美 (STRJ 委員長：東芝)

9:00 - 9:05 来賓ご挨拶 師田 晃彦 室長 (経済産業省 商務情報政策局 デバイス産業戦略室)

Session 1

9:05 - 9:30 International Roadmap Committee (IRC)
「ITRS 2012 改訂版の概要」
石内 秀美 (東芝)

9:30 - 9:55 メトロロジ WG.....
「半導体ウエーハ計測技術の最新動向」
山崎 裕一郎 (東芝)

9:55 - 10:20 歩留向上 WG.....
「歩留向上活動報告～ウエハ処理プロセスのロードマップ～」
白水 好美 (ルネサスエレクトロニクス)

<休憩> (10:20 -10:30) 10 分

Session 2

10:30 - 10:55 設計 WG.....
「Consumer Portable SOC モデルの見直しと今後の取り組み」
中山 勝敏 (ルネサスエレクトロニクス)

10:55 - 11:20 テスト WG.....
「テストの複雑性への新たな挑戦」
安藏 顕一 (東芝)

11:20 – 11:45 Front-End Processes (FEP) WG.....
「新構造・新材料の導入による F E P 技術の革新」
水島 一郎 (東芝)

11:45 – 12:10 Process – Integration and Devices Structures (PIDS) WG.....
「WG6 (PIDS 及び RF&AMS)の活動報告」
若林 整 (東京工業大学)

<昼食> (12:10-13:15) 65 分

特別講演 1

13:15 - 13:55 「フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術の展望」
荒川 泰彦 氏 (東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構長)

特別講演 2

13:55 - 14:35 「抵抗変化型不揮発デバイスで低電圧化限界に挑む」
住広 直孝 氏 (超低電圧デバイス技術研究組合)

<休憩> (14:35 -14:45) 10 分

Session 3

14:45 - 15:10 Emerging Research Devices (ERD) WG.....
「エマージング・リサーチ・デバイスの研究開発動向」
木下 敦寛 (東芝)

15:10 - 15:35 Emerging Research Materials (ERM) WG.....
「新材料インテグレーションにおける挑戦的課題」
秋永 広幸 (産業技術総合研究所)

15:35 - 16:00 MEMS WG.....
「I T R S _MEMS 内容概要と技術動向」
古賀 章浩 (東芝)

<休憩> (16:00 -16:10) 10分

Session 4

16:10 - 16:35 リソグラフィWG.....
「EUV は間に合うか？それともトリプルパターニングか？
ーリソグラフィー技術の最新動向ー」
千々松 達夫 (富士通セミコンダクター)

16:35 - 17:00 配線 WG.....
「STRJ-WG4(配線)活動報告 Cu 配線の微細化限界とブレイクスルー技術」
磯林 厚伸 (東芝)

17:00 - 17:25 実装 WG.....
「低消費電力・高速デバイスの普及を支えるパッケージ開発」
中島 宏文 (ルネサスエレクトロニクス)

17:25 - 17:35 総括 林 喜宏 (STRJ 諮問委員長：ルネサスエレクトロニクス)

17:45 - 懇親会